



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1268

对应国外型号
KTA1268

主要用途

低噪音、音频放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	300mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-120V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-120V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-100mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基 极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-120			V	$I_C=-1\text{mA}$, $I_B=0$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{\text{CB}}=-120\text{V}$, $I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$, $I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	200		700		$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-2\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			-0.3	V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=-1\text{mA}$
$V_{\text{BE(on)}}$	基极—发射极导通电压		-0.65		V	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-2\text{mA}$
f_T	特征频率		100		MHz	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-1\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		4.0		pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$ $f=1\text{MHz}$
NF	噪声系数			6	dB	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-100\mu\text{A}$ $f=10\text{Hz}$, $R_g=10\text{K}\Omega$
				2	dB	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-100\mu\text{A}$ $f=1\text{KHz}$, $R_g=10\text{K}\Omega$
			3		dB	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-100\mu\text{A}$ $f=1\text{KHz}$, $R_g=100\Omega$

分档及其标志

GR

BL

200—400

350—700